
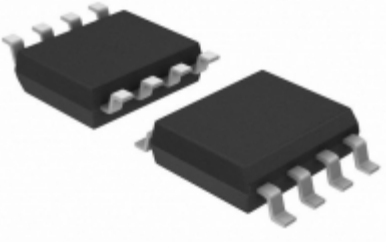
	<h2>SI4170DY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4170DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4170DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1583 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4170DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1583 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 30A (Tc) 3W (Ta), 6W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4355pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4170DY-T1-GE3CT

SI4170DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4170DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4170DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4170DY-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4172DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4170DY-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p><b>SI4168DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4168DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4172DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4172DY</b> VISHAY SI4172DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4172DY-T1-E3</b> V SI4172DY-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI4170DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

SI4156DY	SI4156DY-T1-E3	SI4156DY-T1-GE3	SI4156DY-T1-GE3	SI4160DY
SI4160DY-T1-E3	SI4160DY-T1-GE3	SI4160DY-T1-GE3	SI4160DY-TI-GE3	SI4162DY
SI4162DY-T1-E3	SI4162DY-T1-GE3	SI4162DY-T1-GE3	SI4164DY	SI4164DY-T1-E3
SI4164DY-T1-GE3	SI4164DY-T1-GE3	SI4166DY	SI4166DY-T1-E3	SI4166DY-T1-GE3
SI4166DY-T1-GE3	SI4168DY	SI4168DY-T1-E3	SI4168DY-T1-GE3	SI4168DY-T1-GE3
SI4170DY-T1-GE3	SI4172DY	SI4172DY-T1-E3	SI4172DY-T1-GE3	SI4172DY-T1-GE3
SI4174DY	SI4174DY-T1-E3	SI4174DY-T1-GE3	SI4174DY-T1-GE3	SI4176DY-T1-GE3
SI4176DY-T1-GE3	SI4178DY	SI4178DY-T1-E3	SI4178DY-T1-E3	SI4178DY-T1-GE3
SI4178DY-T1-GE3	SI4186DY-T1-E3	SI4188DY-T1-E3	SI4190ADY	SI4196DY-T1-GE3
SI4196DY-T1-GE3	SI4200-BM	SI4200-BMR	SI4200-GM	SI4200-GMR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited